

2SD1592

NPN 三重拡散形シリコントランジスタ

(ダーリントン接続)

高耐圧低速度スイッチング用

工業用 NPN Silicon Triple Diffused Darlington Transistor
High Voltage, Low Speed Switching
Industrial Use

特 徵

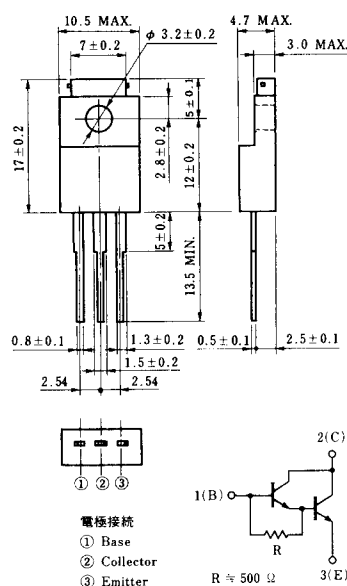
- ゲーリントン接続であるため直流電流増幅率が高い。
- コレクタ飽和電圧が低い。
- 逆阻止型である。
- コンピュータ端本機器のバルスモータドライバ、リレードライバ、汎用小形エンジンのイグナイタ等の用途に最適です。
- 絶縁板および絶縁ブッシングが不要なモールドパッケージです。

絶対最大定格 ($T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	500	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	+300, -10	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	10	V
コレクタ電流	$I_{C(DC)}$	5.0	A
コレクタ電流	$I_{C(pulse)}$ *	10	A
ベース電流	$I_{B(DC)}$	0.5	A
全 損 失	$P_{T(T_a=25^{\circ}C)}$	30	W
全 損 失	$P_{T(T_a=25^{\circ}C)}$	1.5	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^{\circ}C$
保存温度	$T_{storage}$	-55 ~ +150	$^{\circ}C$

* PW $\leq 300 \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 10 \%$

外形圖 (單位: mm)



2SD1592

電気的特性 (T_a = 25 °C)

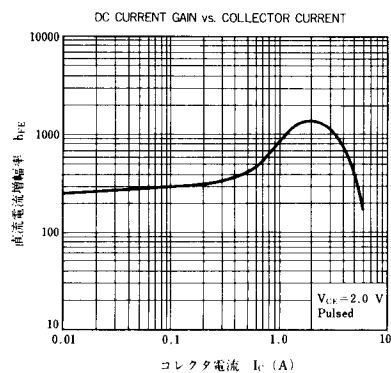
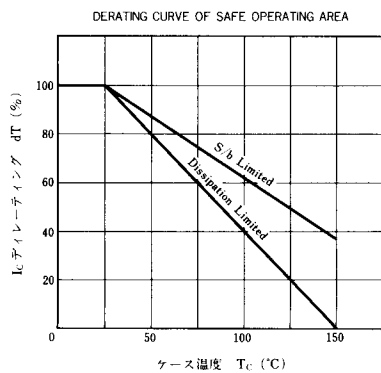
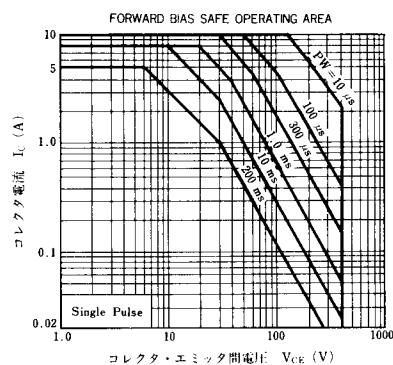
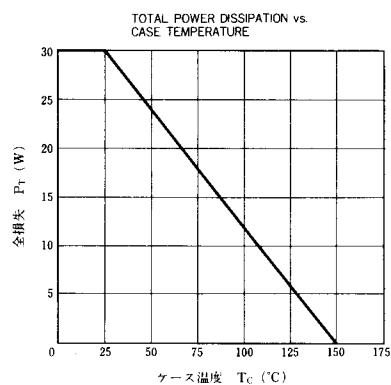
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしや断電流	I _{CBO}	V _{CB} = 400 V, I _E = 0			10	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h _{FE1} *	V _{CE} = 2.0 V, I _C = 2.0 A	400		3000	
直 流 電 流 増 幅 率	h _{FE2} *	V _{CE} = 2.0 V, I _C = 3.0 A	100			
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)} *	I _C = 2 A, I _B = 5 mA		1.0	1.5	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)} *	I _C = 2 A, I _B = 5 mA		1.6	2.0	V
ターンオン時間	t _{on}	I _C = 3.0 A, I _{B1} = -I _{B2} = 30 mA R _L = 50 Ω, V _{CC} = 150 V		1.0		μs
蓄 積 時 間	t _{stg}			12		μs
下 降 時 間	t _f			6		μs

* パルス測定 PW ≤ 350 μs, Duty Cycle ≤ 2 %

h_{FE} 規格区分

捺 印	M	L	K
h _{FE}	400~800	600~1200	1000~3000

特性曲線 (T_a = 25 °C)



6